



Transistor de Potencia MOSFET / 70W / VHF 135-175 MHz / UHF 450-530 MHz / 40V / 20A

SKU: RD70HUF2 Marca: PARTS Categoría: Misceláneo

\$1,737.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este transistor de potencia MOSFET está diseñado para aplicaciones de amplificación RF en bandas VHF y UHF, ofreciendo una solución robusta para sistemas de comunicación de alta potencia. Su arquitectura optimizada permite alcanzar una eficiencia del drenaje de hasta 74% en la banda de 175 MHz, reduciendo significativamente las pérdidas térmicas y mejorando la confiabilidad del sistema. La integración de un diodo de protección para la puerta simplifica el diseño del circuito driver y protege contra sobretensiones transitorias. Con capacidad de disipación de 300W y resistencia térmica de 0.5°C/W, este dispositivo soporta condiciones de operación exigentes en amplificadores de transmisión profesionales.

Características Principales

- Potencia de salida de hasta 84W típica**
- Eficiencia del drenaje del 74% a 175 MHz**
- Diodo integrado de protección para la puerta**
- Diseñado para amplificadores VHF/UHF de alta potencia**
- Empaque en cinta y carrete: 500 unidades por carrete**

Especificaciones Eléctricas

Parámetro	Condición	Valor
Potencia de salida	175 MHz, 40V, 100% Duty	84W típico
Eficiencia del drenaje	175 MHz, 40V, 100% Duty	74% típico
Disipación térmica	300W	0.5°C/W
Resistencia térmica	0.5°C/W	0.5°C/W
Potencia de Entrada	40V, 100% Duty	5.5W
Formato	Cinta y Carrete	500 unidades

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia del drenaje del 74% a 175 MHz
Característica 2	Diodo integrado de protección para la puerta
Característica 3	Diseñado para amplificadores VHF/UHF de alta potencia
Característica 4	Disipación térmica de canal de 300W
Característica 5	Resistencia térmica de 0.5°C/W
Característica 6	Empaque en cinta y carrete de 500 unidades